

К ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ НЕОДНОРОДНОЙ
СЛАБОИОНИЗОВАННОЙ ПЛАЗМЫ, ПОМЕЩЁННОЙ
В ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Б. М. Маркеев

Параметрическое возбуждение волн в плазме внешним электрическим ВЧ полем в настоящее время вызывает значительный интерес. В работе¹ было показано, что в бесстолкновительной однородной плазме, находящейся в сильном высокочастотном поле, в определённых условиях возникает неустойчивость и происходит возбуждение электромагнитных волн. С точки зрения эксперимента всегда представляло интерес возбуждение колебаний в слабом поле и определение пороговых амплитуд, начиная с которых происходит данное возбуждение. Теоретические пороговые значения напряжённости высокочастотного поля в незамагниченной плазме исследовались в²⁻⁴. При этом теоретические выводы относительно малости пороговых напряжённостей согласуются с экспериментальными данными работы⁵. В настоящей работе исследуется вопрос устойчивости неоднородной замагниченной слабоионизованной плазмы, помещённой в слабое ВЧ поле в гидродинамической области частот и длин волн.

Как известно, в гидродинамической области (ω , $kv_{te} \ll v_{al}$) в неоднородной замагниченной плазме существуют две ветви дрейфовых колебаний⁶:

$$\omega = \omega_n \left\{ 1 + \frac{\omega_{te}}{\omega_n} (1+S) - i \left[\frac{2}{3} \frac{k^2 \chi''}{\omega_n v_{te}} + 2 \frac{m_e}{m_i} \frac{v_{te}}{\omega} \right] \times \right. \\ \left. \times \frac{\omega_{te}}{\omega_n} (1+S) \right\} \quad \text{при} \quad \frac{(k_x v_{te})^2}{\omega \sqrt{\epsilon_n}} \ll 1 ; \quad (1)$$

$$\omega = \omega_{ne} \left\{ 1 - \left(\frac{k^2}{\omega_{ne}} \chi''_e \right)^{-1} \frac{\omega_{pe}}{\omega_{ne}} (1 + S) \right\} \quad (2)$$

при $\frac{(k_e v_{te})^2}{\omega^2 v_{en}^2} > 1 > \frac{(k_e v_{ti})^2}{\omega^2 v_{in}^2}$.

Здесь $\omega_d = \frac{k_e T_{ea}}{m_a \Omega_a} \frac{\partial \ln A}{\partial x}$ — дрейфовая частота, где

$A = n_{ea}$, T_{ea} , $P_{ea} = n_{ea} T_{ea}$ — равновесная концентрация, температура и давление соответственно,

χ''_e — коэффициент продольной теплопроводности. Эти спектры неустойчивы при наличии градиента температуры; в плазме с однородной температурой колебания устойчивы. Ниже будет показано, что внешнее слабое ВЧ поле с отрицательной расстройкой ($\Delta\omega_o = \omega_o - \omega_d < 0$) в системе с однородной температурой приводит к раскачке этих колебаний, аналогично постоянному продольному току⁷. При этом существенно, что неустойчивость возникает при напряжённостях внешних ВЧ полей, меньших, чем пороговые поля, определяющие неустойчивость в однородной плазме³. В работе также обсуждаются вопросы стабилизации дрейфовых колебаний плазмы с неоднородной температурой слабым ВЧ полем при положительной расстройке ($\Delta\omega_o = \omega_o - \omega_d > 0$).

Рассмотрим слабоионизованную неоднородную вдоль оси ox плазму, помещённую в однородное продольное магнитное поле (ось oz) и в слабое высокочастотное электрическое поле, для определённости направленное вдоль магнитного поля. Задачу об устойчивости такой системы относительно малых потенциальных возмущений будем решать на основе линеаризованных уравнений Больцмана

$$\begin{aligned} \frac{\partial \delta f_a}{\partial t} + \vec{v}_a \frac{\partial \delta f_a}{\partial \vec{r}_a} + e_a \left\{ \vec{E} + \frac{1}{c} \left[\vec{v}_a \vec{B} \right] \right\} \frac{\partial \delta f_a}{\partial \vec{v}_a} = \\ = \int d\vec{v}_a' d\Omega \sigma(w, \Theta) w \left\{ \delta f_a f_n - \delta f_a' f_n' \right\}, \end{aligned} \quad (3)$$

где $w = |\vec{v}_a - \vec{v}_n|$, θ - угол рассеяния, $\sigma(w, \theta)$ - дифференциальное сечение рассеяния, и уравнение Пуассона

$$\operatorname{div} \delta \vec{E} = 4\pi \sum_e \epsilon_e \delta n_e. \quad (4)$$

Ограничимся анализом спектра в гидродинамической области частот ($\omega, k v_{ra} < v_{an}$), но будем считать, что частота внешнего поля выше частот соударений электронов с нейтралами и электронной циклотронной частоты ($\omega_0 > v_{an}, \Omega_a$). Решение уравнения (3) будем искать в виде

$$\delta t_a = \sum_n \delta \xi_a^{(n)} \exp - i [(\omega + n\omega_0)t - \vec{k}\vec{r}]. \quad (5)$$

Высокочастотную часть возмущения плотности можно определить непосредственно из выражения (5)

$$\eta_e^{(n)} = - \frac{k^2}{4\pi \epsilon_e} \delta \epsilon_e (\omega + n\omega_0, \vec{k}) \sum_m I_{n-m}(a) \Phi^{(m)}, \quad (6)$$

где

$$\delta n_e = \eta_e \exp - i a \sin \omega_0 t; \quad a = \frac{k_z u_z}{\omega_0}; \quad u_z = \frac{\epsilon_e E_z}{m_e \omega_0}, \quad \text{и}$$

$$\delta \epsilon_e^{(n)} (\omega + n\omega_0, \vec{k}) = - \frac{\omega_0^2}{(\omega + n\omega_0)^2} \left[1 - i \frac{v_{en}}{(\omega + n\omega_0)} \right] \quad (7)$$

Здесь v_{en} - частота столкновений³. Низкочастотную часть возмущения плотности ($n = 0$) мы будем искать на основе решения уравнения (3) методом Грэда, т.е. будем исходить из уравнений гидродинамики⁸. Приводя замену (7) и

$$\begin{aligned} \delta u_{ez} &= w_z \exp - ia \sin \omega_0 t \\ \delta T_e &= \theta \exp - ia \sin \omega_0 t, \end{aligned} \quad (8)$$

систему уравнений гидродинамики можно свести к виду, полученному в работе⁷, из которого определим выражение для возмущения низкочастотной части плот-

ности. Последнее будет определяться выражением, аналогичным полученному в работе⁷. Для случая слабого поля, подставляя в уравнение Пуассона возмущения плотностей электронов и ионов, определённых из уравнений Больцмана для высокочастотной и уравнений гидродинамики для низкочастотной частей возмущений плотностей, окончательно получим следующее дисперсионное уравнение колебаний плазмы в ВЧ поле

$$\frac{1}{\delta \epsilon_e(\omega)} + \frac{1}{\delta \epsilon_i(\omega)} + \frac{a^2}{4} \left(\frac{1}{\epsilon(\omega - \omega_0)} + \frac{1}{\epsilon(\omega + \omega_0)} \right) = 0 \quad (9)$$

где $\epsilon = 1 + \delta \epsilon_e + \delta \epsilon_i$, а выражения для $\delta \epsilon_e$ и $\delta \epsilon_i$ приведены в 7.

Проанализируем уравнение (9) в предельных случаях больших и малых коэффициентов теплопроводности. Решая это уравнение, получим два спектра в соответствующих предельных случаях:

$$\omega = \omega_{ne} \left\{ 1 + \frac{\omega_{re}}{\omega_{ne}} (1+S) - i \left[\frac{2}{3} \frac{k_z^2}{\omega} \frac{\chi''_e}{n_{oe}} + 2 \frac{m_e}{m_i} \frac{v_{en}}{\omega} \right] \frac{\omega_{re}}{\omega_{ne}} (1+S) - \right. \\ \left. - i \left(\frac{\omega_{ne} v_{en}}{(k_z v_{re})^2} \frac{1}{(kr_e)^2} - \frac{a^2}{2} \left[\left(\frac{2 \Delta \omega_0}{\omega_0} \right)^2 + \frac{v_{en}^2}{\omega_0^2} \right]^{-1} \right) \right\} \quad (10)$$

при $\frac{(k_z v_{re})^2}{\omega v_{en}} < 1$;

$$\omega = \omega_{ne} < 1 - i \left(\frac{k_z^2}{\omega} \frac{\chi''_e}{n_{oe}} \right)^{-1} \frac{\omega_{re}}{\omega_{ne}} (1+S) + \frac{1}{(kr_e)^2} - \frac{a^2}{2} \frac{2 \Delta \omega_0}{\omega_0} \times \\ \times \left[\left(\frac{2 \Delta \omega_0}{\omega_0} \right)^2 + \frac{v_{en}^2}{\omega_0^2} \right]^{-1} \left\{ 1 - i \left[\left(\frac{k_z^2}{\omega} \frac{\chi''_e}{n_{oe}} \right)^{-1} + \left(\frac{k_z v_{re}}{\omega} \right)^{-1} \right] \right\} \quad (11)$$

при $\frac{(k_z v_{re})^2}{\omega v_{en}} < 1 < \frac{(k_z v_{re})^2}{\omega v_{en}^2}$,

где $r_e = v_{re}/\omega_{re}$ – дебаевский радиус электронов.

Как видно из (10) и (11), в плазме с однородной тем-

пературой малое внешнее ВЧ поле при отрицательных расстройках ($\Delta\omega_0 < 0$) вызывает неустойчивость, в то время как в отсутствии ВЧ поля эти спектры устойчивы. Выражения (11) и (12) выписаны в предположении, что все характерные времена задачи больше времени джоулевого нагрева. Поэтому приведённый анализ справедлив для интервала частот:

$$\frac{v_{en}^2}{\omega_0} \frac{v_{re}^2}{\omega_{en}} \left(\frac{k_z v_{re}}{\sqrt{\omega_{en}}} \right)^2 < \omega^2 < \frac{v_{en}^2}{\omega_0}. \quad (12)$$

Представляет интерес определить интервал минимальных напряжённостей ВЧ поля, возбуждающих спектры (11) и (12). Эти интервалы можно записать соответственно в виде

$$\frac{v_{en}}{\omega_0} \left| \left(\frac{(k_z v_{re})^2}{\omega_0 v_{en}} \right)^3 \right| < \frac{E^2}{4\pi n_{oe} T_{oe}} < \frac{v_{en}}{\omega_0} \left(\frac{(k_z v_{re})^2}{\omega_{en} v_{en}} \right)^2, \quad (13)$$

$$\frac{\omega_{ne}}{\omega_0} < \frac{E^2}{4\pi n_{oe} T_{oe}} < \frac{v_{en}}{\omega_0}. \quad (14)$$

Из (13) видно, что в безграничной плазме практически любые малые напряжённости ВЧ поля вызывают неустойчивость. В случае плазмы конечных размеров минимальное значение продольного волнового вектора

$k_{z\min} = \frac{L}{L}$, где L – продольный размер системы; оно и определяет пороговую напряжённость ВЧ поля. Отметим, что условие пренебрежения джоулевым нагревом

$$(u_e^2/v_{re}^2 < (k_z v_{re})^2/v_{en}^2)$$

не противоречит неравенствам (14), (15). Заметим также, что поля, определяемые неравенствами (13) и (14), меньше пороговых полей для возбуждения колебаний в однородной плазме³. Из выражений (10), (11) видно, что при положительных расстройках ($\Delta\omega_0 > 0$) внешнее ВЧ поле обладает стабилизирующим действием на дрейфовые колебания. Амплитуды внешнего ВЧ поля, необходимые для стабилизации плазмы с неоднородной температу-

рой, при оптимальных расстройках ($\Delta\omega_0 = \sqrt{\epsilon_n}/2$) равны

$$\frac{E^2}{4\pi n_{oe} T_{oe}} \geq \frac{\sqrt{\epsilon_n}}{\omega_0} \left| \frac{(k_z v_{re})^2}{\omega \sqrt{\epsilon_n}} \left[\frac{2}{3} \frac{k_z^2 \chi_e''}{\omega n_{oe}} + 2 \frac{m_e}{m_i} \frac{\sqrt{\epsilon_n}}{\omega} \right] \frac{\omega_{re}}{\omega_{ne}} (1+S) \right|$$

при $\frac{(k_z v_{re})^2}{\omega \sqrt{\epsilon_n}} < 1$, (15)

$$\frac{E^2}{4\pi n_{oe} T_{oe}} \geq \frac{\sqrt{\epsilon_n}}{\omega_0} \left| \frac{\omega_{re}}{\omega_{ne}} \left(\frac{k_z^2 \chi_e''}{\omega} \right)^{-1} (1+S) \left\{ \left(\frac{k_z^2 \chi_e''}{\omega n_{oe}} \right)^{-1} + \left(\frac{(k_z v_{re})^2}{\omega \sqrt{\epsilon_n}} \right)^{-1} \right\}^{-1} \right|$$

при $\frac{(k_z v_{re})^2}{\omega \sqrt{\epsilon_n}} < 1 < \frac{(k_z v_{re})^2}{\omega \sqrt{\epsilon_n}}$. (16)

В заключение отметим, что наличие малого постоянного тока в плазме с однородной температурой также приводит к неустойчивости⁷. Эту токовую неустойчивость можно стабилизовать ВЧ полем при условии

$$\frac{E^2}{4\pi n_{oe} T_{oe}} \geq \frac{\sqrt{\epsilon_n}}{\omega_0} \left| \frac{k_z u_0}{\omega} \right|, \quad (17)$$

Выражаю благодарность А.А. Рухадзе за обсуждение результатов работы.

Поступила в редакцию 19 ноября 1969 г.

После переработки 16 декабря 1969 г.

Л и т е р а т у р а

1. Силин В. П., ЖЭТФ 48, 1679 (1965).
2. Dubois D.F., Goldmann M.V., Phys. Rev. 164, №1, 207 (1967).
3. Nishikawa K., Journ. Phys. Soc. Japan, 24, 916 and 24, 1152 (1968).

4. Андреев Н. Е., Кирий А. Ю., Силин В. П., ЖЭТФ 57, № 13, 1028 (1969).
5. Геккер И. Р., Сиэухин О. В., Письма ЖЭТФ, в.7 (1969).
6. Байков И. С., Рухадзе А. А., ЖТФ т.38, 1619 (1968).
7. Байков И. С., Коган Е. Я., Моисеев С. С., Рухадзе А. А. ЖТФ т.39, 230 (1969).
8. Алиевский М. Я., Жданов В. М., ПМТФ № 5, 11 (1963).